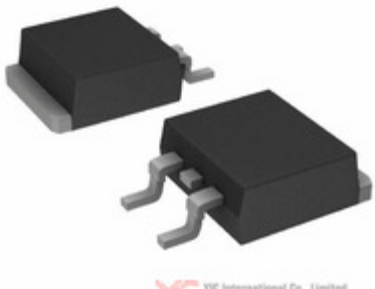

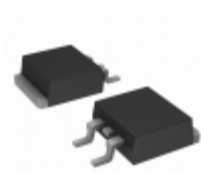

	<p>Hersteller-Teilenummer: IPB049NE7N3 G</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: IPB049NE7N3 G Infineon Technologies</p>
	<p>Datenblätter:  IPB049NE7N3 G.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, 20500 pcs Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	IPB049NE7N3 G
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	IPB049NE7N3 G Infineon Technologies
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	20500 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.8V @ 91µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.9 mOhm @ 80A, 10V
Verlustleistung (max)	150W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4750pF @ 37.5V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	68nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	75V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	80A (Tc)

IPB049NE7N3 G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB049NE7N3 G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB049NE7N3 G International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPB049NE7N3 G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPB049N06L3 G INFINEON IPB049N06L3 G INFINEON</p>	 <p>IPB048N15N5LFATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 150V 120A TO263-3</p>	 <p>IPB04CNE8NG VB IPB04CNE8NG VB</p>	 <p>IPB049N06L3GATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 80A TO263-3</p>
 <p>IPB04N03LA Infineon Technologies MOSFET N-CH 25V 80A D2PAK</p>	 <p>IPB049N08N5ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 80V TO263-3</p>	 <p>IPB049NE7N3G INF IPB049NE7N3G INF</p>	 <p>IPB049N06L3G INF IPB049N06L3G INF</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB049NE7N3 G International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB049NE7N3 G Datenblatt	IPB049NE7N3 G-Datenblätter	IPB049NE7N3 G PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB049NE7N3 G
IPB049NE7N3 G Electronic	IPB049NE7N3 G-Komponenten	IPB049NE7N3 G-Verteiler	IPB049NE7N3 G-Bild	IPB049NE7N3 G-Teil
IPB049NE7N3 G Preis	IPB049NE7N3 G Hersteller	IPB049NE7N3 G Bild	IPB049NE7N3 G Aktie	IPB049NE7N3 G Inventar
IPB049NE7N3 G Neu	IPB049NE7N3 G Original	IPB049NE7N3 G garantiert	IPB049NE7N3 G RFQ	IPB049NE7N3 G Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited